[Article]

www.whxb.pku.edu.cn

聚乙烯-碳黑复合材料的太赫兹时域光谱研究

宋玉峰^{1,2} 朱智勇^{1,*} 吉 特¹ 葛 敏¹ 陈西良¹ 刘 崎¹ (¹中国科学院上海应用物理研究所,上海 201800; ²中国科学院研究生院,北京 100049)

摘要: 利用太赫兹时域光谱(THz-TDS)技术在 0.3-2.0 THz 频率区间测量了不同碳黑含量(φ)的聚乙烯-碳黑复合材料光电性质随频率的变化及其与碳黑含量之间的关系.测量发现,随碳黑含量的增加,复合体系的吸收系数逐渐增大,并伴随折射率的相应增加.在碳黑含量确定的情况下,材料的吸收系数随频率的增加而增大,但折射率随频率的增加而略有减小.在假定复合体系中孤立碳黑颗粒在外电场作用下的极化过程是引起材料太赫兹频区介电损耗主要因素的情况下,利用德拜偶极子弛豫理论对聚乙烯-碳黑复合材料的介电行为进行了解释.

关键词: 聚乙烯-碳黑复合材料; 太赫兹时域光谱; 介电性质 中图分类号: O649, O657.99

THz Time-domain Spectroscopic Study of Polyethylene-Carbon Black Composites

SONG Yu-Feng^{1,2} ZHU Zhi-Yong^{1,*} JI Te¹ GE Min¹ CHEN Xi-Liang¹ LIU Qi¹ (¹ Shanghai Institute of Applied Physics, Chines Academy of Sciences, Shanghai 201800, P. R. China; ²Graduate School of the Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, P. R. China)

Abstract: Terahertz time-domain spectroscopic technique was applied to investigate the optical properties of polyethylene-carbon black composites in the frequency range of 0.3-2.0 THz as a function of frequency and volume fraction of the carbon black. It is found that the absorption coefficient and the refractive index of the composite increased with increase of carbon black content. At the same carbon black concentration, the absorption coefficient increased and the refractive index decreased with increase of frequency. The experimental measurements were analyzed by using Debye theory of dipole relaxation under the assumption that carbon black particles dispersed in the polyethylene matrix behave like dipoles and contribute mainly to the dielectric loss.

Key Words: Polyethylene-carbon black(PE-CB) composite; THz time-domain spectra; Dielectric properties

太赫兹(THz)辐射通常是指介于 0.1-10 THz 之 间的电磁波辐射, 在电磁波谱中太赫兹波处于红外 和微波之间. 这一区域蕴含有物质丰富的物理和化 学信息, 如凝聚态物质的载流子在此区域有非常灵 敏的响应. 但由于缺乏经济有效的太赫兹源和检测 设备, 长期以来, 太赫兹技术远远落后于红外技术和 微波研究. 20 世纪 90 年代以来, 先进材料和超快激 光技术的发展极大地促进了太赫兹技术的发展. 由 于太赫兹时域光谱(THz-TDS)技术能同时给出 THz 光波的振幅和相位,因此可直接得到太赫兹频区内 材料的光学和电学性质¹¹,避免了通常利用 Kramers-Kronig 转换所带来的不确定性¹².

聚合物-碳黑复合材料同时具有导电材料和绝缘基质的优点,因此在工业领域有广泛的应用.例如可用作温控元件^{13.41}和电磁屏蔽材料等.研究这类材料性能以及它们与碳黑含量及结构间的相互关系具有重要意义.目前关于这类材料电学和光学性质的研究已有不少文献报道¹⁶,但在太赫兹频区的实验研

Received: July 12, 2006; Revised: September 11, 2006.

^{*}Corresponding author. Email: zhuzhiyong@sinap.ac.cn; Tel: +8621-59556904.

国家自然科学基金(10675157)资助项目

究非常少.最近 Reedijk 等⁶⁶设计了一套准光学装置, 用于对此类材料介电特性在太赫兹频区的无接触测 量,精确获得了材料在 0.03-0.6 THz 频段介电常数 的色散关系.这些结果对于认识载流子传输和偶极 子弛豫等物理性质具有重要意义.

本文利用 THz-TDS 技术在 0.3-2.0 THz 频率 区间研究了不同碳黑含量的聚乙烯-碳黑(PE-CB)复 合材料的光学性质. 探讨了这类材料的光学性质随 频率的变化规律以及这种关系与复合体系中碳黑含 量、碳黑颗粒分布状态等的相互联系.

1 实验部分

1.1 样品的制备

不同碳黑含量的聚乙烯-碳黑复合材料的制备 参照文献[7]. 其中聚乙烯为结晶度 80%的高密度聚 乙烯,熔体流动指数(MFI)为 0.39,密度为 0.95 g·cm⁻³, 室温下体积电阻率为 $2.03 \times 10^{17} \Omega$ ·cm;高结构碳黑 (HG-CB)颗粒为直径尺寸约33 nm的多孔状中空球, 比表面积(BET, N₂)为1080 m²·g⁻¹,孔隙率为5.86 mL· g⁻¹,挥发性成分质量分数 $\leq 0.3\%$, pH 值为 6.5 左右, 室温下体积电阻率约为 0.27 Ω ·cm.

碳黑含量用体积分数(φ)表示. 将高密度聚乙烯 和高结构碳黑按一定比例在 190 ℃机械搅拌混合, 然后在 150 ℃挤压成 1 mm 厚的薄片. 高密度聚乙 烯薄片的制备过程同上, 只是制备过程中不加碳黑. 进行太赫兹光谱测量时样品被切成 10 mm×10 mm× 1 mm 的薄片.

1.2 仪器设备和数据处理

THz-TDS 装置见文献[8], 实验数据的分析处理 如文献[9, 10]所述. 实验在室温下进行, 由于水汽在 太赫兹频段的吸收很强, 因此测试过程中以高纯氮 气保护以消除水汽的影响^[11]. 在垂直入射的情况下, 通过分别测量样品和参考样的 THz-TDS, 经傅立叶 转换获得样品和参考样的太赫兹频域谱. 若用氮气 氛为参比, 则理论上可由下式获得样品的 THz 透射 率 *H*(ω):

$$H(\omega) = \frac{2\tilde{n}_{sam} \cdot 2\tilde{n}_{ref}}{(\tilde{n}_{sam} + \tilde{n}_{ref})^2} \cdot \exp\left[-i(\tilde{n}_{sam} - \tilde{n}_{ref})\frac{\omega \cdot d}{c}\right] \cdot FP(\omega)$$
$$=\rho_{th} \cdot \exp(-i\phi_{th}) \tag{1}$$

式(1)中各参数的下标 sam 和 ref 分别对应测试样品 和参考样品; ω 为光波频率; \tilde{n} (= n_r -i n_i , n_r 和 n_i 分别是 样品的折射率和消光系数) 是测试样品的复折射系 数;d 是测试样品的厚度;c 是光速; FP(ω)项代表与 样品前后表面反射相关的量,即 Fabry-Pérot 效应; $\rho_{th} 和 \phi_{th} 分别为光波穿过样品与参考样后,光波的$ 振幅之比和相位差.

由于本文中的样品吸收较强, 故数据处理中忽略了 FP(ω)项的影响(即取 FP(ω)=1). 在实验获得光 波穿过样品和参考样后的振幅和相位后, 可利用公 式(1)进行拟合得到样品的光学参数(*n*, 和 *n*_i). 得到 消光系数 *n*_i 后, 可以利用 α(ω)=4π*n*/λ(λ 为波长)求 得样品的功率吸收系数(α).

2 结果和讨论

图1比较了不同复合体系的太赫兹脉冲时域 谱.可以看出,随着复合体系中碳黑含量(φ)的增加, 穿过材料的太赫兹波信号强度逐渐减小,与参比的 相位差依次增大.聚乙烯在太赫兹频段对光的吸收 很小,故相对于入射光波太赫兹波信号强度几乎没 有变化,但有明显的相移.图2是通过傅立叶变换获 得的太赫兹频域谱,可以观察到透过聚乙烯-碳黑复 合材料后,随着碳黑含量的增加,太赫兹波的功率急 剧减小.在 φ=2.57% 时峰值处的电场功率只有原来 的约13%, 而在 φ=8.67% 时峰值电场功率只有原来 的约 0.2%. 根据测量的噪声水平, 对各样品透射光 谱的信号进行了评判,确定了各样品可信数据的频 率范围. 例如对于碳黑含量分别为 13.27%、8.67%、 5.01%、2.57%、1.04%的样品,其测量数据分别在 0.3-0.4、0.3-0.7、0.3-1.1、0.3-1.8、0.3-2.0 THz 区间 可信,以下就对这些结果进行分析讨论.

非极性高聚物聚乙烯(PE)由于在太赫兹频区吸 收很小,常被用作太赫兹光学窗.本次测量得到 PE



图 1 聚乙烯和掺碳聚乙烯以及参比样的太赫兹时域谱 Fig.1 THz -TDS for virgin PE, PE-CB composites (dot line) and reference (N₂ atmosphere, solid line) Spectra for composites with high CB (carbon) contents were magnified due to their very weak intensities.



Fig.2 Fourier transform spectra of THz time-domain measurements for PE, PE-CB composites and reference (N₂)

The spectra of PE-CB composites with high content were magnified.

在所测量频率区间的功率吸收系数(α)小于 5 cm⁻¹, 与文献[9]结果相近,存在的小差异可能与样品制备 过程中使用的添加剂不同有关.图 3 为不同碳黑含 量掺碳聚乙烯材料的功率吸收系数随频率的变化关 系.可以看出,加入碳黑后材料的功率吸收系数随碳 黑含量的增加逐渐增大,且当碳黑含量一定时,功率 吸收系数随频率的增大而增大.图 4 给出几个频率 下功率吸收系数随碳黑含量的变化关系.结果显示, 在所研究的碳黑含量范围里,吸收系数随碳黑含量 增大近似呈线性增加.碳黑的添加对太赫兹光的吸 收应归因于碳黑中导电载流子对太赫兹波电场能量 的吸收.随体系中碳黑含量的增加,导电载流子数目 逐渐增多,致使功率吸收系数相应增加¹⁰.

文献[9]报道聚乙烯在太赫兹频段的折射率在 1.52 左右,我们测得的数值(图 5)与之吻合.从图 5 可看出,随着复合体系中碳黑含量的增加,折射率



图 3 不同碳黑宫重疹碳聚乙烯材料的切率吸收系数 (a)随频率(f)的变化关系









(n)逐渐增大.但对于同一碳黑含量,折射率随太赫兹 频率的增大呈下降趋势.图 6 给出几个频率下折射 率随碳黑含量的变化关系.从图 6 可看出,在所研究 的碳黑含量范围里,折射率随碳黑含量的增加呈指 数增大,用式n=n₀+a·φ^b(a和b是拟合参数,φ是碳黑体 积分数, n₀是纯聚乙烯的折射率)进行拟合,可得n₀ 约 为 1.52, 幂指数 b 约为 1.1.

下面尝试利用德拜的偶极子弛豫理论¹¹³对测量 结果给予解释. 掺碳聚乙烯复合材料中碳黑颗粒在 外电场作用下,荷电载流子在其中的相对移位可近 似为偶极子弛豫,因此复合材料的介电性质可由式 (2)和式(3)描述:

.

$$\varepsilon_{r} = \varepsilon_{\infty} + \frac{\varepsilon_{s} - \varepsilon_{\infty}}{1 + \omega^{2} \tau^{2}} = n_{r}^{2} - n_{i}^{2}$$
⁽²⁾

$$\varepsilon_{i} = \frac{\sigma}{\omega} + \frac{(\varepsilon_{s} - \varepsilon_{\infty}) \cdot \omega \tau}{1 + \omega^{2} \tau^{2}} = 2n_{i}n_{i}$$
(3)

其中包含了由电导(电导率 *o*)产生的介电损耗.式 中 *c*_r 是介电常数实部, *c*_i 是介电常数虚部, *c*_s 是静



图 5 不同碳黑含量掺碳聚乙烯复合材料的折射率 (n)随频率(f)的变化关系



The solid lines are fittings to the experimental results by using Debye theory of dipole relaxation.



图 6 聚乙烯-碳黑复合材料的折射率(n)随碳黑 含量(φ)的变化关系 Fig.6 Refractive index (n) of PE-CB composites as a function of carbon black content (φ) at

specified frequencies

态介电常数, ε_{*}是高频(光学)介电常数, τ是偶极子 弛豫时间.由式(2-3)可计算得到复合材料的折射率 (n,)和消光系数(n_i),并进而求得材料的功率吸收系 数α(ω)(α(ω)=4πn_i/λ).表1给出了通过式(2)和式(3)拟 合图3和图5数据获得的材料介电性质.由表1可见, 对所研究的复合体系,偶极子的弛豫时间在0.1 ps左 右.随碳黑含量增加 (见图7),电导率以约1.18的指数 关系增加,而静态介电常数ε_{*}和高频介电常数ε_{*}的

表 1 聚乙烯-碳黑复合材料的拟合参数

Table 1Fitting parameters for polyethylene-carbonblack composites with various carbon black contents

$\varphi(\%)$	\mathcal{E}_{∞}	$\boldsymbol{\mathcal{E}}_{\mathrm{s}}$	$\Delta \varepsilon$	τ/ps	$\sigma/(S \cdot m^{-1})$
1.04	2.418	2.553	0.135	0.099	3.11
2.57	2.538	2.861	0.323	0.112	6.93
5.01	2.712	3.577	0.865	0.114	15.08
8.67	2.725	4.671	1.946	0.116	30.34
13.27	2.7 ± 0.3	6.4 ± 0.6	3.6 ± 0.4	0.12 ± 0.01	48.4 ± 4.8

 φ : volume fraction of the carbon black; ε_{∞} : high frequency dielectrics; ε_{s} : static dielectrics; $\Delta \varepsilon = \varepsilon_{s} - \varepsilon_{\infty}$





图 7 聚乙烯-碳黑复合材料电导率 σ 和 Δε 值随碳 黑含量的变化关系

Fig.7 Electrical conductivities (σ) and optical parameters $\Delta \varepsilon$ obtained for PE-CB composites as a function of carbon black content 差值Δε(=ε_s-ε_{*})随碳黑含量的增加以约1.52的指数 关系增加.由于Δε通过Δε=Nμ²/3kT与碳黑颗粒数密 度N以及碳黑颗粒的有效偶极矩μ相联系(式中k为玻 尔茨曼常数,T为温度),因此我们认为这种偏离线性 的现象应该与碳黑颗粒结构的变化相联系,也即随 着碳黑含量的增加,不仅碳黑颗粒数密度增大,而且 颗粒半径的增大也会导致有效偶极矩的增大.

3 结 论

利用太赫兹光谱技术获取了 0.3-2.0 THz 频率 区间不同碳黑含量的聚乙烯-碳黑复合材料的光学 参数,并通过假定碳黑颗粒的极化是复合材料在太 赫兹频区介电损耗的主要原因,由此利用德拜偶极 子弛豫理论对复合体系光学参数在此频率区间的色 散关系进行了解释,获得了不同碳黑含量聚乙烯-碳 黑复合体系的介电参数.

研究结果表明,复合材料的吸收系数和折射率 随碳黑含量的增加而显著增大;在相同碳黑含量时, 体系的吸收系数随频率的增大而增大,但折射率随 频率的增加略有减小.聚乙烯-碳黑复合体系的这些 性质可以由德拜的偶极子弛豫理论得到很好的描述.拟合实验结果获得的偶极子弛豫时间约为0.1 ps,随碳黑含量变化很小,但静态介电常数和高频介 电常数的差值随碳黑含量以1.52的指数关系增大, 认为这种偏离线性关系的现象与碳黑颗粒尺寸随碳 黑含量增加而增大的情况相联系.

References

- Matthew, C. B.; Gordon, M. T.; Charles, A. S. J. Phys. Chem. B, 2002, 106: 7146
- 2 Jeon, T. I.; Grischkowsky, D.; Mukherjee, A. K.; Menon, R. Appl. Phys. Lett., 2000, 77(16): 2452
- 3 Yang, G. C. Polym. Compos., 1997, 18(4): 484
- 4 Yang, G. C.; Teng, R. R.; Xiao, P. Polym. Compos., **1997**, **18**(4): 477
- 5 Balberg, I. Carbon, 2002, 40: 139
- 6 Reedijk, J. A.; Martens, H. C. F.; Smits, B. J. G.; Brom, H. B. *Rev. Sci. Instrum.*, 2000, 71(2): 478
- 7 Patnaik, A.; Zhu, Z.; Yang, G.; Sun, Y. Phys. Status Solid A, 1998, 169: 115
- 8 Xu, H.; Han, J. G.; Yu, X. H.; Li, W. X.; Zhu, Z. Y.; Li, L. F.; Ji, T. Struct. Chem., 2004, 15(6): 573
- 9 Fischer, B. M.; Walther, M.; Jepsen, P. U. Phys. Med. Biol., 2002, 47: 3807
- Duvillaret, L.; Garet, F.; Coutaz, J. L. *IEEE. J. SEL. TOP. QUANT.*, 1996, 2(3): 739
- 11 Jeon, T. I.; Grischkowsky, D. Appl. Phys. Lett., 1998, 72(18): 2259
- 12 Chen, C. L. Solid state physics. Xi'an: Northwestern Polytechnical University Press, 1998 [陈长乐. 固体物理学. 西安: 西北工业大 学出版社, 1998]
- 13 Yin, Z. W. Physics of dielectrics. (2nd ed. Beijing: Science Press, 2003 [殷之文. 电介质物理学(第二版). 北京: 科学出版社, 2003]